

产品特性：

工作频率：4.4~5GHz

饱和输出功率： $P_{\text{sat}} \geq 43\text{dBm}$

功率增益： $\text{Gain} \geq 23\text{dB}$

工作效率： $\eta = 30\%$ (type)

端口匹配： $Z_{\text{in}}/Z_{\text{out}} = 50\Omega$

产品说明：

HXNM40008是一款氮化镓内匹配功率管，采用先进的平面内匹配合成技术和成熟的薄膜混合集成工艺，产品的典型工作频带为4.4~5GHz，具有高功率、高效率及温度等环境适应性等特点，能够广泛应用于各种射频/微波系统中。

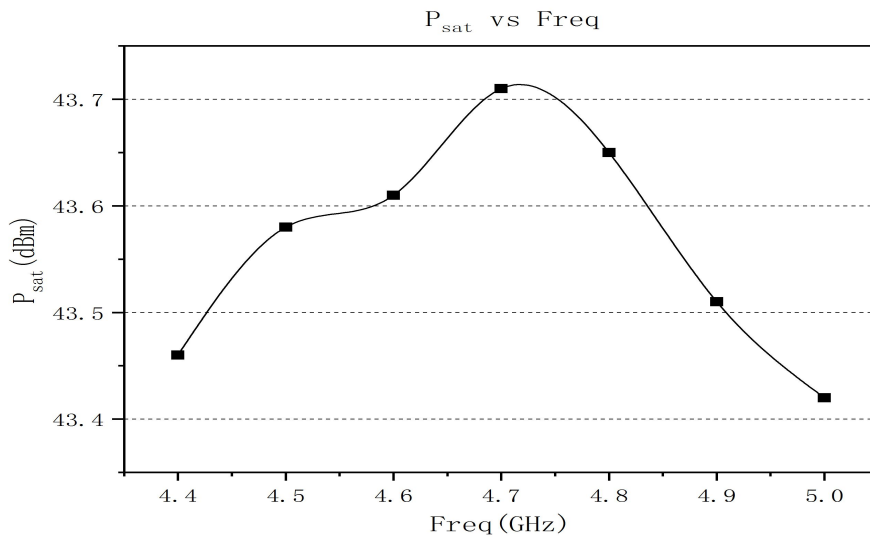
最大额定值 ($T_c = 25^\circ\text{C}$ ，不推荐在此条件下工作)：

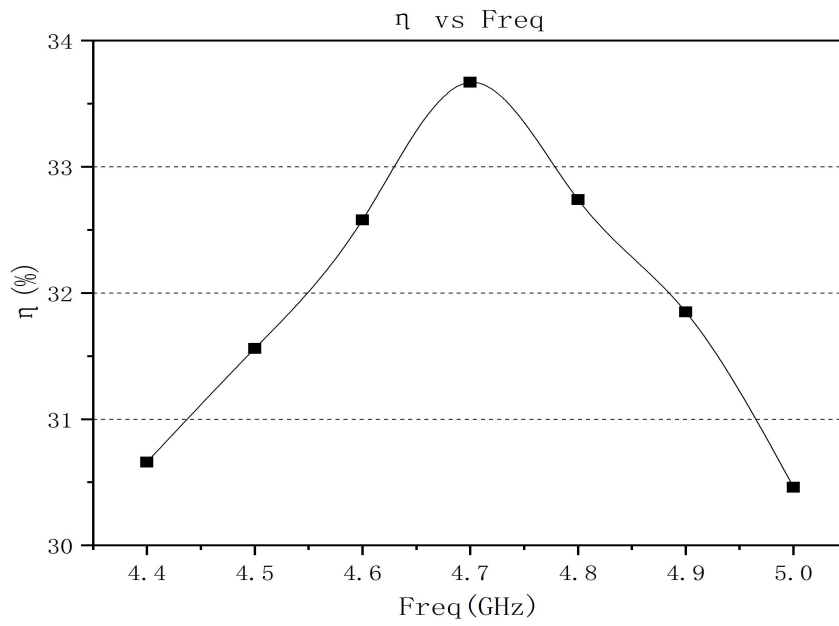
	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	40	V
栅源电压	V_{GS}	-5	V
存储温度	T_{stg}	-65 to +175	$^\circ\text{C}$
沟道温度	T_{ch}	175	$^\circ\text{C}$

微波电性能：

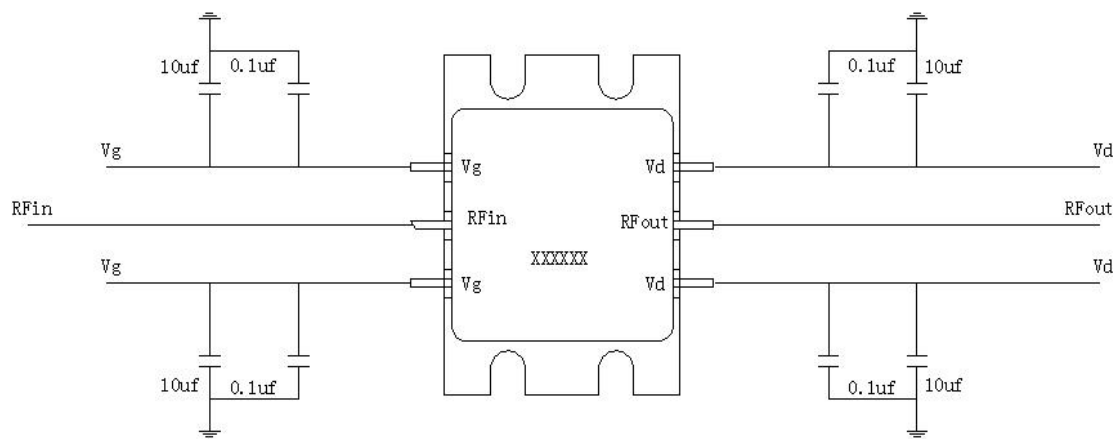
	符号	测试条件	值			单位
			Min	Typ	Max	
漏极电流	I_{dsr}	$V_{DS}=28V$ 连续波工作 $P_{in} : 20dBm$ Freq : 4.4~5GHz	-	2.4	-	A
饱和输出功率	P_{sat}		43	-	-	dBm
功率增益	G_p		23	-	-	dB
工作效率	η		-	30	-	%
增益平坦度	ΔG		-0.8	-	+0.8	dB

典型曲线：





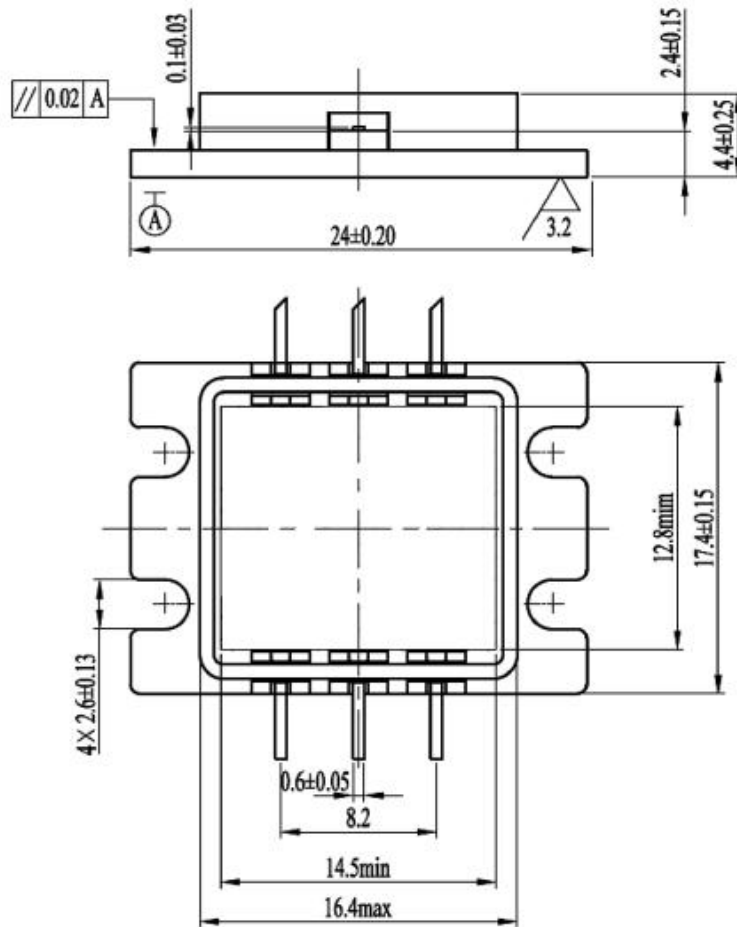
推荐应用电路：



防静电等级：

ESD	Class III	2000V
-----	-----------	-------

外观尺寸：



使用注意事项：

- 运输存储过程中注意干燥。
- 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯。
- 加电时先加栅电再加漏电。